

次世代パワーデバイスの実装技術と最新動向

～ SiC, GaNパワーデバイスの選定とその特徴の活かし方をわかりやすく指導～

日時
2018年 6月29日 (金)
10:30 ~ 16:30

税込受講料
1名 48,600円
2名以上1名 45,360円
案内図



飯田橋駅下車 各徒歩約5分
JR中央線(緩行線)
地下鉄東西線(A5出口)
地下鉄有楽町線・南北線(A4・B2a出口)
都営地下鉄大江戸線(A4出口)

<お申込要項>

- ・参加ご希望の方は、HP・E-mail・FAX 電話、何れかにてお申込ください。
- ・お申込に際し、社名・部署名・受講者名 住所・連絡先(TEL・FAX・E-mail)をお知らせください。
- ・お申込次第、受講票・請求書等を発送します。受講料のお支払は銀行振込・当日持参のいずれかでお願いします。
- ・受講料は講座後のお支払いも対応致します。(個人申込除く)
- ・開催日前14日以降のキャンセルはお受けできません。
- ・受講者数が開催基準定員に満たない場合は中止になります。

会場 産業科学システムズ会議室(東京都千代田区富士見1-5-1)

講座の趣旨・POINT

1. 最新のパワーエレクトロニクスは、地球環境問題や電力消費削減に貢献する技術であり、我が国が世界をリードして行ける分野である。さらに今後の成長分野として注目される。
2. IoT、AI(人工知能)、ロボティクスおよび宇宙開発といった先進分野においてもパワーエレクトロニクス 技術が必要不可欠である。
3. パワーエレクトロニクス装置の中核を成すパワー半導体においてはSiからSiC/GaNへの大きな変化が始まっている。

本講座は、次世代パワー半導体のアプリケーション・取り巻く環境から信頼性設計までを、パッケージ(実装)技術を中心に解説します。次世代パワー半導体の制御回路、基板の設計・製造に携わるエンジニアの皆様最新の技術をお伝えします。

講師

富士電機株式会社 電子デバイス事業本部 開発統括部
パッケージ開発部 工学博士 両角朗氏

内容

- ・パワーエレクトロニクスとパワー半導体
 1. パワーエレクトロニクスの歴史
 2. パワー半導体の歴史
 3. パワー半導体のアプリケーション
 4. パワー半導体を取り巻く環境(動向)
 - ・パワー半導体素子とパッケージの動向
 1. パワー半導体素子の動向
 2. パッケージの動向
 3. WBG(Wide-band-Gap)半導体の動向
 4. パワー半導体モジュールの要求性能
 - ・パワー半導体モジュールのパッケージ技術
 1. モジュールの構造と機能
 2. 接合技術(はんだ接合、次世代半導体に対応した高耐熱接合)
 3. 接続技術(ワイヤボンディング、リードフレーム接合など)
 - ・パワー半導体モジュールのパッケージ技術
 1. 封止技術(シリコーンゲル、ハードレジン)
 2. 絶縁技術(セラミック、樹脂絶縁)
 3. 放熱技術(TIM, 冷却器, 直接水冷)
 - ・信頼性
 1. インバータの信頼性
 2. モジュールの破壊メカニズム
 3. モジュールの信頼性設計技術
 4. 高信頼性化事例
- Solution and Consulting / 質疑応答

お申込・お問合せは

主催 ISS 産業科学システムズ
<http://www.ebrain-j.jp/>

TEL (03)3264-5635 FAX (03)3264-5675
E-mail: education@ebrain-j.com

申込書 FAXは 03-3264-5675

講座参加申込書 次世代パワーデバイスの実装技術と最新動向

セミナーコード

1101-180629

太枠内をご記入の上FAX (03-3264-5675) してください。

2018/6/29 ISS

社名	所在地	〒	電話	()
No.	所属部課(正式名称)	氏名	E-mail アドレス	-
			FAX	()
			お支払予定	当日ご持参 銀行振り込み
この講座をお知りになった媒体を○で囲んでください パンフ はがき Eメール ホームページ 検索サイト() その他				